

DHA[®]

QJ/DHA 09.13-2018

9N90

N-沟道 MOSFET 功率晶体管

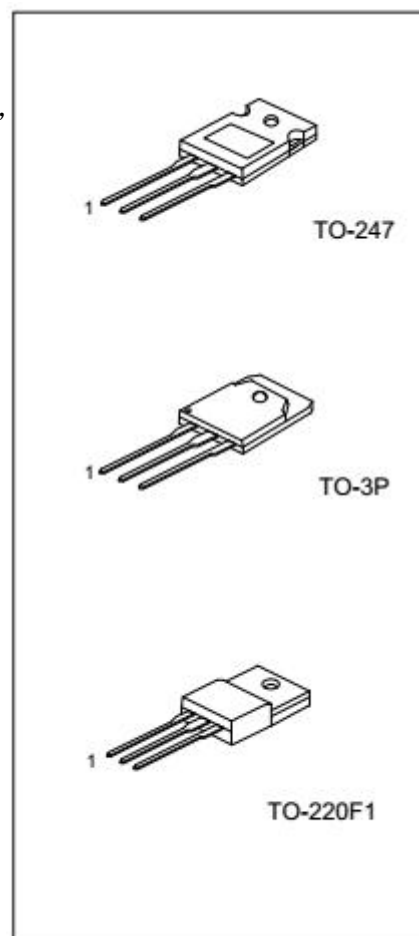
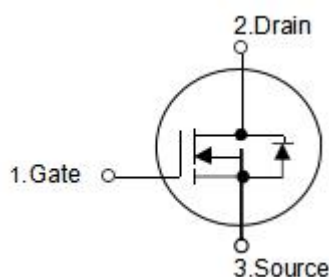
描述

9N90 采用先进的专有平面条纹 DMOS 技术, 可提供出色的 $R_{DS(ON)}$, 低栅极电荷和低栅极电压工作。

用途

该器件适合用作负载开关或 PWM 应用。

等效电路图



电参数 (Tamb = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV_{DSS}	漏极-源极 击穿电压	V	900	-	-	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\ \mu\text{A}$
I_D	漏极连续电流	A	-	-	9.0	$T_j = 25\ ^\circ\text{C}$
$R_{DS(on)}$	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	1.12	1.4	$V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 4.5\text{ A}$
$V_{GS(th)}$	栅极门限电压	V	3.0	-	5.0	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\ \mu\text{A}$
I_{DSS}	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	10	$V_{DS} = 900\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$
I_{GSS}	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	$V_{GS} = \pm 30\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$
T_j	工作结温	$^\circ\text{C}$	- 55 ~ +150			
T_{STG}	储存温度范围	$^\circ\text{C}$				